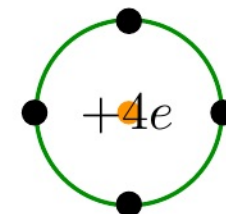
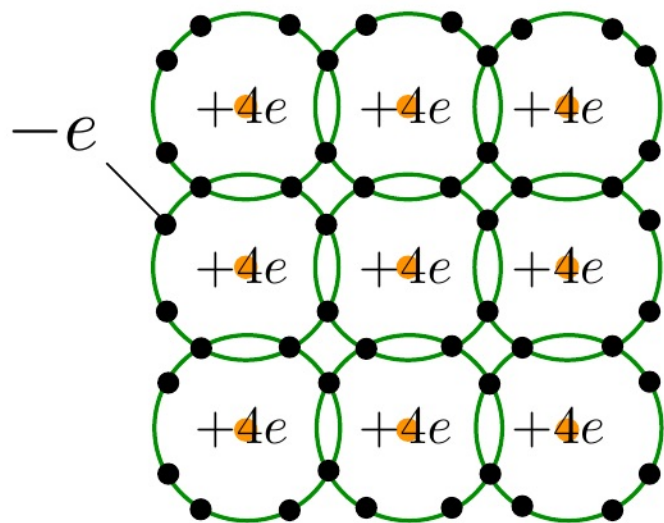


n型半導体の作り方

電氣的に中性



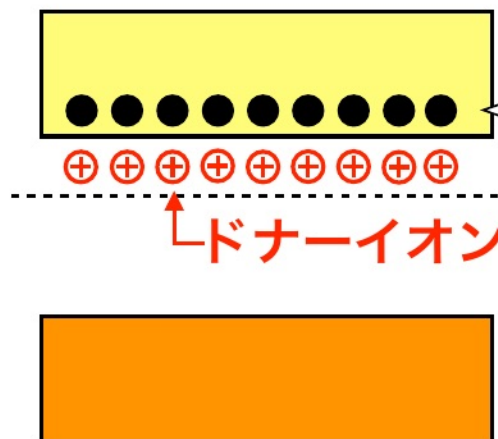
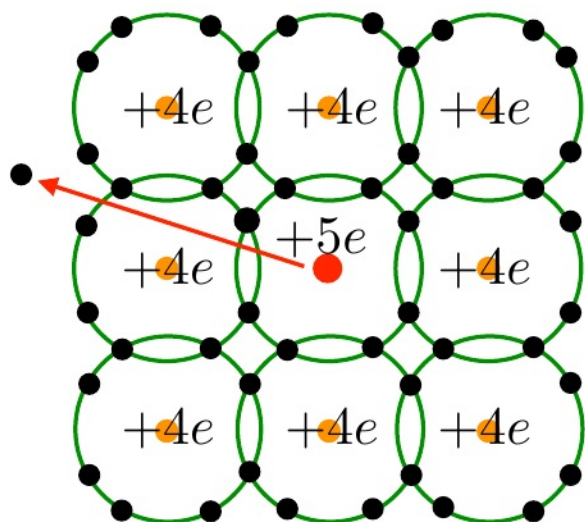
真性半導体 Si (4価) 結晶



共有結合により
価電子帯の電子は
埋まっている

不純物濃度を
 10^{13} 個/cm³から 10^{20} 個/cm³
程度まで変化させる

n型半導体 5価の元素 (不純物) をドーピング



共有結合の電子が余る



伝導帯に電子が存在